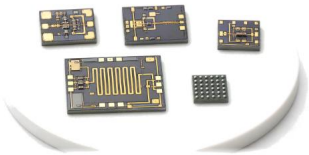
Produktkatalog

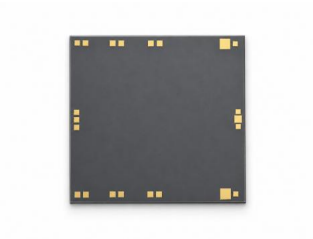
Bare-Die- und Chip-Scale-HF-Bauelemente

Bare-Die- und Chip-Scale-HF-Bauelemente sparen Gehäusefläche und Parasitäreffekte, übertragen aber Montage, Masseführung, Wärmeweg und Verifikation an den Integrator. Verglichen werden Prüfgrad, Geometrie, Metallisierung und Rückverfolgbarkeit.



Produkte: 244

Revision: 62 · Revisionsdatum: 2026-11-12



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

11500–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für Mikrowellen-Sendestufen von 11,5 bis 18 GHz. Beide HF-Signalpfade besitzen eine Gleichstromsperre. Der Chip unterstützt CW- und Pulsbetrieb.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 11500; Maximum: 18000; Wert: 11500–18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 19.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (Minimum) / 42.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (Minimum) / 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 35 % (Minimum). Chipabmessungen: 3 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 42; Typisch: 42.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-14200-16800-PS48T

14200–16800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 14200; Maximum: 16800; Wert: 14200–16800; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-14500-17200-PS48T

14500–17200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 14500; Maximum: 17200; Wert: 14500–17200; Einheit: MHz

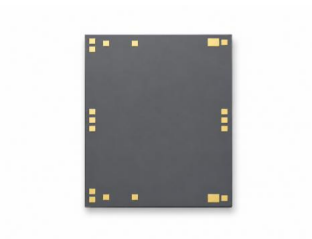
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

13750–14500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (Minimum); Leistungsverstärkung: 20 dB (Minimum); PAE: 37 % (Minimum) / 38 % (typisch). Chipabmessungen: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 13750; Maximum: 14500; Wert: 13750–14500; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Sättigungsausgangsleistung: 46 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 5 × 6 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 13750; Maximum: 15250; Wert: 13750–15250; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Typisch: 46; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (Minimum) / 48.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 23 dB (Minimum) / 23.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 44 % (typisch). Chipabmessungen: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 48; Typisch: 48.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Minimum: 23; Typisch: 23.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

13800–18200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 47 dBm (Minimum) / 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (Minimum) / 21.5 dB (typisch); PAE: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 13800; Maximum: 18200; Wert: 13800–18200; Einheit: MHz

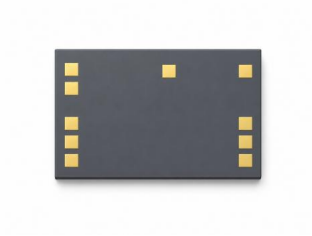
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 21.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 37 dBm (Minimum) / 37.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 15 dB (Minimum) / 15.5 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 37; Typisch: 37.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 15; Typisch: 15.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

12200–16000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 46 dBm (Minimum) / 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 19.5 dB (typisch); PAE: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 12200; Maximum: 16000; Wert: 12200–16000; Einheit: MHz

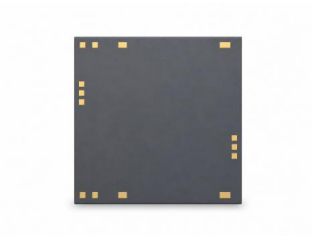
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 19.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

26000–40000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Leistungsverstärkung: 15 dB (typisch); PSAT: 40.5 dBm (typisch); PAE: 23 % (typisch). Chipabmessungen: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 26000; Maximum: 40000; Wert: 26000–40000; Einheit: MHz

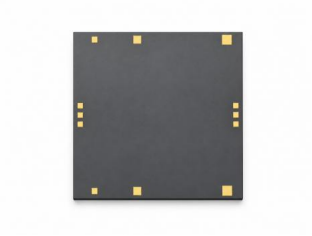
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 22; Einheit: dB

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 15; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-31000-37000-PS41T

31000–37000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 21 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 31000; Maximum: 37000; Wert: 31000–37000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-33000-37000-PS45T

33000–37000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 45 dBm (typisch); PAE: 22 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 33000; Maximum: 37000; Wert: 33000–37000; Einheit: MHz

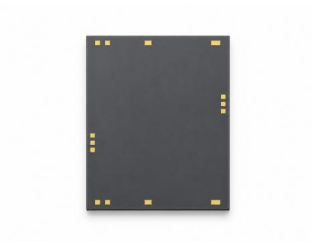
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

18000–40000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 40.5 dBm (typisch); PAE: 15 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 21 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 18000; Maximum: 40000; Wert: 18000–40000; Einheit: MHz

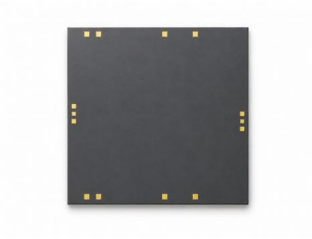
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 40.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-92000-96000-PS36T

92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 36 dBm (typisch); PAE: 9 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 36; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-27000-31000-PS43T

27000–31000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 43 dBm (typisch); PAE: 28 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 27000; Maximum: 31000; Wert: 27000–31000; Einheit: MHz

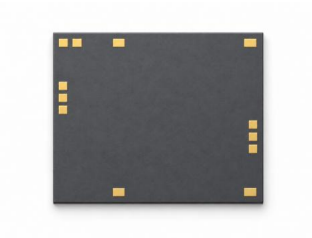
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 43; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-50000-63000-PS37T

50000–63000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 37 dBm (typisch); PAE: 20 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (typisch). Chipabmessungen: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 50000; Maximum: 63000; Wert: 50000–63000; Einheit: MHz

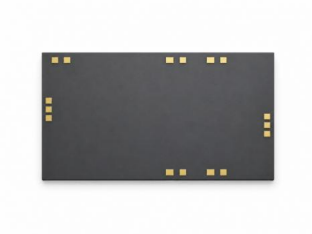
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1.5; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 37; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-92000-96000-PS34T

92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 34 dBm (typisch); PAE: 10 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

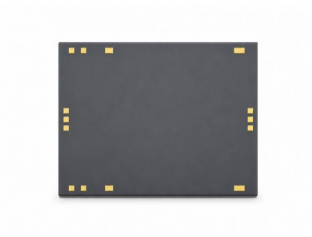
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 34; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-18000-26500-PS41T

18000–26500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 18000; Maximum: 26500; Wert: 18000–26500; Einheit: MHz

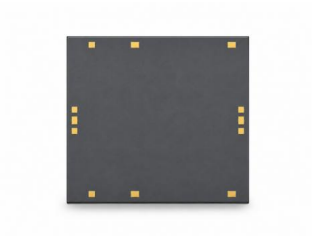
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.4; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-27000-31000-PS42T

27000–31000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 42 dBm (typisch); PAE: 30 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 27000; Maximum: 31000; Wert: 27000–31000; Einheit: MHz

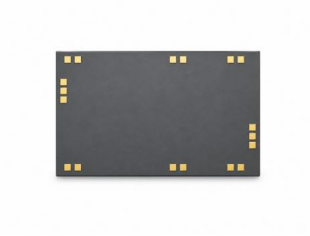
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-15000-43000-PS30T

15000–43000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 30 dBm (typisch); PAE: 18 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (Minimum) / 20 dB (typisch) / 22 dB (Maximum). Chipabmessungen: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 43000; Wert: 15000–43000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Minimum: 18; Typisch: 20; Maximum: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±2; Einheit: dB

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 29.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

92000–96000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 26.5 dBm (typisch); PAE: 12 % (typisch) / 13 % (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 26.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

15000–17000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 37 % (typisch). Chipabmessungen: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 17000; Wert: 15000–17000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-12700-14500-PS47T

12700–14500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 46.8 dBm (Minimum) / 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18.8 dB (Minimum) / 19 dB (typisch); PAE: 37 % (typisch). Chipabmessungen: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 12700; Maximum: 14500; Wert: 12700–14500; Einheit: MHz

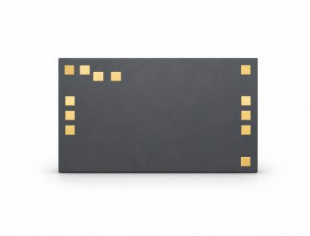
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46.8; Typisch: 47; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 18.8; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-15000-18000-PS38T

15000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 38 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 40 % (typisch). Chipabmessungen: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 18000; Wert: 15000–18000; Einheit: MHz

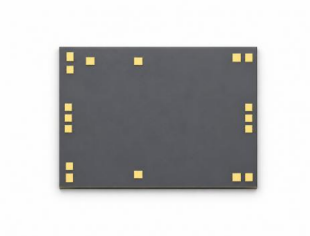
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 38; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-13000-15000-PS42T

13000–15000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (Minimum) / 37 % (typisch). Chipabmessungen: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 13000; Maximum: 15000; Wert: 13000–15000; Einheit: MHz

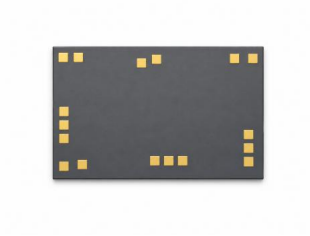
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

5000–13000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); PAE: 30 % (typisch). Chipabmessungen: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

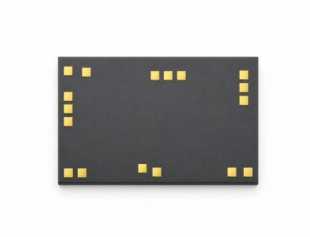
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 31; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

5000–13000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); PAE: 30 % (typisch). Chipabmessungen: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 31; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

12000–15000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 47 dBm (Minimum) / 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (Minimum) / 22.5 dB (typisch); PAE: 30 % (Minimum) / 34 % (typisch). Chipabmessungen: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 12000; Maximum: 15000; Wert: 12000–15000; Einheit: MHz

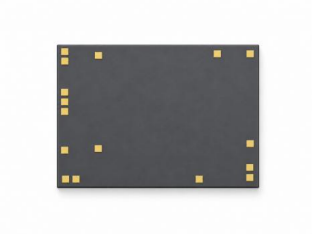
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

8000–12000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

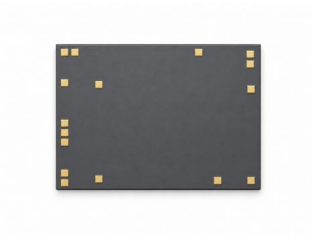
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

8000–12000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

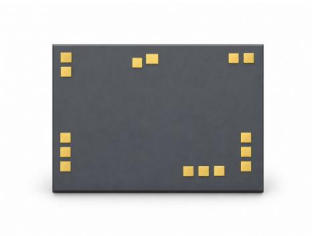
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

9000–10000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 10000; Wert: 9000–10000; Einheit: MHz

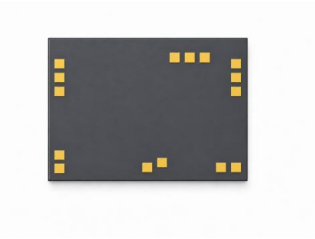
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

9000–10000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 10000; Wert: 9000–10000; Einheit: MHz

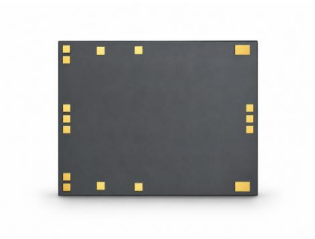
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

15000–17000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); PAE: 43 % (typisch). Chipabmessungen: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 17000; Wert: 15000–17000; Einheit: MHz

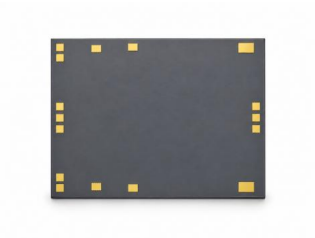
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-14000-18000-PS45T

14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); PAE: 41 % (typisch). Chipabmessungen: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-15000-18500-PS48T

15000–18500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 18500; Wert: 15000–18500; Einheit: MHz

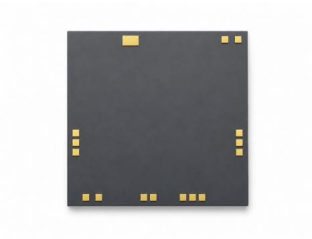
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

300–6000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 38.7 dBm (Minimum) / 39 dBm (typisch) / 40.5 dBm (Maximum); Leistungsverstärkung: 10.7 dB (Minimum) / 11 dB (typisch) / 12.5 dB (Maximum); PAE: 30 % (Minimum) / 35 % (typisch) / 53 % (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Wert: 300–6000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 38.7; Typisch: 39; Maximum: 40.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 10.7; Typisch: 11; Maximum: 12.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.9; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-13750-15350-PS48T

13750–15350 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 47 dBm (Minimum) / 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 13750; Maximum: 15350; Wert: 13750–15350; Einheit: MHz

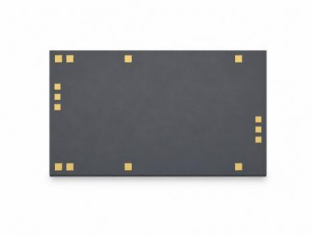
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-34000-64000-PS30T

34000–64000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 30 dBm (typisch); PAE: 17 % (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 34000; Maximum: 64000; Wert: 34000–64000; Einheit: MHz

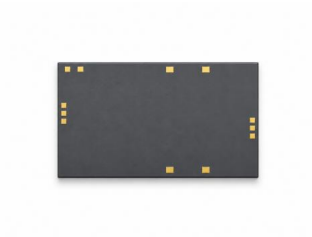
Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 27; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 30; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 34.5 dBm (typisch); PAE: 14 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 22 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Symbol: S21; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 34.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.7 dB (typisch) / 0.75 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 26.5 dB (Minimum) / 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 10; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Minimum: 26.5; Typisch: 28; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.7 dB (typisch) / 0.75 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 26.5 dB (Minimum) / 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 10; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Minimum: 26.5; Typisch: 28; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 5 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 15000; Wert: 14000–15000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 32; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 5 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 15000; Wert: 14000–15000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 32; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch) (Vd = +5 V); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 15 dBm (typisch) (Vd = +5 V). Chipabmessungen: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 800; Maximum: 4000; Wert: 800–4000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 15; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 32; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch) (Vd = +5 V); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 15 dBm (typisch) (Vd = +5 V). Chipabmessungen: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 800; Maximum: 4000; Wert: 800–4000; Einheit: MHz

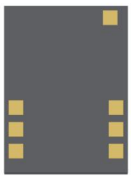
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 15; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 32; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32.3 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 30; Maximum: 600; Wert: 30–600; Einheit: MHz

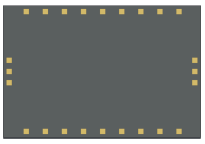
Kleinsignalverstärkung: Typisch: 32.3; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±0.3; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 2.8 dB (typisch) (f = 90000 MHz); Rauschzahl: 3.3 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 25 dB (typisch) (f = 75000–90000 MHz); Kleinsignalverstärkung: 22 dB (typisch) (f = 90000–110000 MHz). Chipabmessungen: 2 × 3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 75000; Maximum: 110000; Wert: 75000–110000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 25; Einheit: dB; Hinweise: f = 75000–90000 MHz

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 22; Einheit: dB; Hinweise: f = 90000–110000 MHz

Eingangsrückflussdämpfung: Typisch: 6; Einheit: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.3 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 26 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 4 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 17000; Maximum: 22000; Wert: 17000–22000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 26; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Typisch: ±0.5; Einheit: dB

Rauschzahl: Typisch: 1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch) / 0.7 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 16.5 dBm (typisch) / 17.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 43 dBm (Maximum) (τ = 1 ms; D = 20%). Chipabmessungen: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

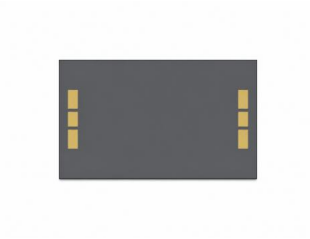
Einfügedämpfung: Typisch: 0.6; Maximum: 0.7; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.4

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.45 dB (typisch) / 0.5 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 18.5 dBm (typisch) / 19.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 49 dBm (Maximum) (τ = 2 ms; D = 20%); Maximale gepulste Eingangsleistung: 50 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.45; Maximum: 0.5; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.5 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 42 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

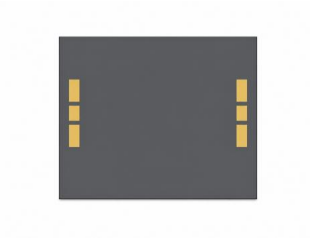
Einfügedämpfung: Typisch: 0.5; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch) / 0.4 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 43 dBm (Maximum) (τ = 200 µs; D = 20%). Chipabmessungen: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

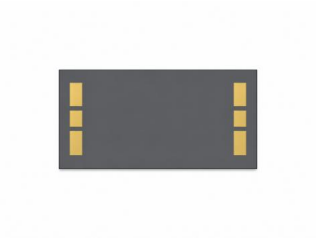
Einfügedämpfung: Typisch: 0.3; Maximum: 0.4; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.4

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16.5 dBm (typisch) / 17.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 42 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

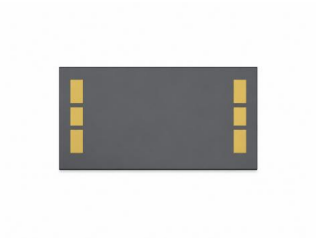
Einfügedämpfung: Typisch: 0.8; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.6

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.6

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 41 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.6; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.5

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 48 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%); Maximale Eingangsleistung: 46 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.8; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.5

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch) / 0.5 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 14000; Wert: DC–14000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.4; Maximum: 0.5; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch) / 0.7 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.6; Maximum: 0.7; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.6

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.6

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.3; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.3; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 200 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 10000; Maximum: 18000; Wert: 10000–18000; Einheit: MHz

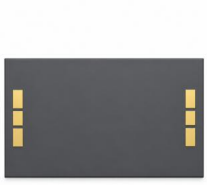
Einfügedämpfung: Typisch: 0.8; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.6; Maximum: 1.8

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.6; Maximum: 1.8

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.35 dB (typisch) / 0.4 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.35; Maximum: 0.4; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.4; Maximum: 1.5

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.4; Maximum: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 51 dBm (Maximum) (τ = 100 µs; D = 10%); Maximale Eingangsleistung: 48 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 4000; Wert: 2000–4000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.4; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die

Einfügedämpfung: 1 dB (typisch); Isolation: 34 dB (Minimum) / 63 dB (Maximum); Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: 43 dBm (typisch). Chipabmessungen: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 1000; Maximum: 12000; Wert: 1000–12000; Einheit: MHz

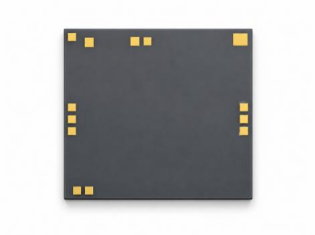
Einfügedämpfung: Typisch: 1; Einheit: dB

Isolation: Minimum: 34; Maximum: 63; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 43; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2700-3900-PS31T

2700–3900 MHz GaAs-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 30.5 dBm (Minimum) / 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 35.5 dB (Minimum) / 36 dB (typisch); PAE: 45 % (Minimum) / 48 % (typisch). Chipabmessungen in der Draufsicht: 2.5 × 2.262 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

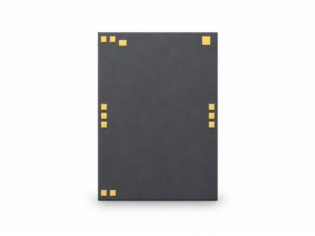
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 30.5; Typisch: 31; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 35.5; Typisch: 36; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

2700–3900 MHz GaAs-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 34 dBm (Minimum) / 34.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 29 dB (Minimum) / 29.5 dB (typisch); PAE: 47 % (Minimum) / 49 % (typisch). Chipabmessungen in der Draufsicht: 2.2 × 3.092 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 34; Typisch: 34.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 29; Typisch: 29.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 °; Dämpfungsbereich: 0–31.5 dB; Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 11 dBm (Minimum) / 13 dBm (typisch). Chipabmessungen: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Minimum: 7.5; Maximum: 10; Wert: TX / RX; Einheit: dB

Isolation: Minimum: 35; Einheit: dB

Dämpfungsbereich: Wert: 0–31.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz Vierkanal-SiGe-T/R-Beamformer als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 °; Dämpfungsbereich: 0–31.5 dB; Schaltzeit: 100 ns (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 5 × 6.2 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

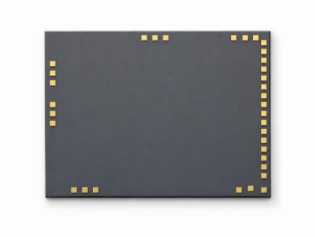
Ein-/Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.8

RMS-Phasenfehler: Maximum: 3; Einheit: °

RMS-Dämpfungsfehler: Maximum: 0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 ° (typisch); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 12 dB (typisch) (RX). Chipabmessungen: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

Kleinsignalverstärkung: Typisch: 12; Wert: RX; Einheit: dB

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Typisch: 11; Wert: RX; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Typisch: 24; Wert: TX; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz Zweikanal-Si-T/R-Beamformer als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 ° (typisch); Dämpfungsschritt: 0.5 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

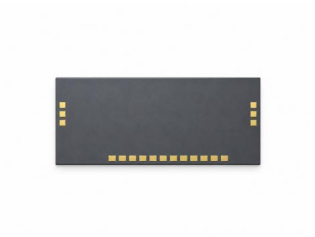
Auflösung der Phasensteuerung: Wert: 6; Einheit: bit

Auflösung der Dämpfungssteuerung: Wert: 6; Einheit: bit

Phasenstellbereich: Minimum: 0; Maximum: 360; Einheit: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 0.5 ° (Minimum) / 0.7 ° (typisch) / 1 ° (Maximum); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum); Einfügedämpfung: ≈5 dB. Chipabmessungen: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 1200; Maximum: 1400; Wert: 1200–1400; Einheit: MHz

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Minimum: 0.5; Typisch: 0.7; Maximum: 1; Einheit: °

Phasenbedingte Amplitudenänderung: Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1 ° (typisch); Einfügedämpfung: 7 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

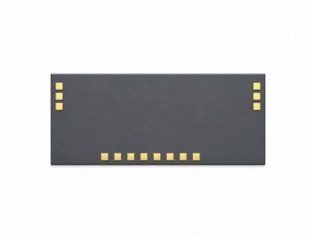
Einfügedämpfung: Typisch: 7; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1; Einheit: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1 ° (typisch); Einfügedämpfung: 5.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 5.5; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1; Einheit: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.4 ° (typisch); Einfügedämpfung: 9.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 15000; Maximum: 23000; Wert: 15000–23000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 9.5; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1.4; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.6 ° (typisch); Einfügedämpfung: 9.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 25000; Maximum: 33000; Wert: 25000–33000; Einheit: MHz

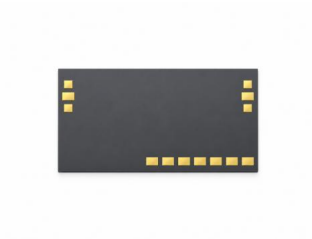
Einfügedämpfung: Typisch: 9.5; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1.6; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.2 ° (typisch); Einfügedämpfung: 7 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

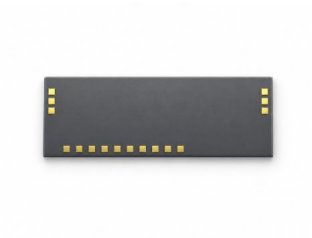
Einfügedämpfung: Typisch: 7; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1.2; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.5 ° (typisch); Einfügedämpfung: 5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 900; Maximum: 1400; Wert: 900–1400; Einheit: MHz

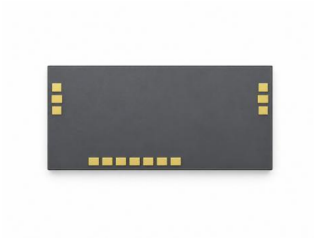
Einfügedämpfung: Typisch: 5; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 1.5; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 0.8 ° (typisch); Einfügedämpfung: 4.3 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 1200; Maximum: 1600; Wert: 1200–1600; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 4.3; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 0.8; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 2.2 ° (typisch) / 3 ° (Maximum); Einfügedämpfung: 10 dB (typisch) / 11.5 dB (Maximum); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 8000; Wert: 2000–8000; Einheit: MHz

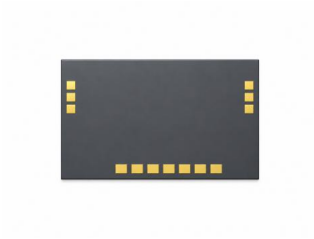
Einfügedämpfung: Typisch: 10; Maximum: 11.5; Einheit: dB

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

RMS-Phasenfehler: Typisch: 2.2; Maximum: 3; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Dämpfungsglied als Bare Die

RMS-Dämpfungsfehler: 0.3 dB (typisch); Einfügedämpfung: 4 dB (Maximum); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum). Chipabmessungen: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

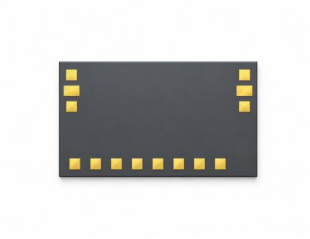
Einfügedämpfung: Maximum: 4; Einheit: dB

Dämpfungsbereich: Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

RMS-Dämpfungsfehler: Typisch: 0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Dämpfungsglied als Bare Die

RMS-Dämpfungsfehler: 0.2 dB (typisch); Einfügedämpfung: 1.6 dB (typisch); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum). Chipabmessungen: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 8000; Wert: DC–8000; Einheit: MHz

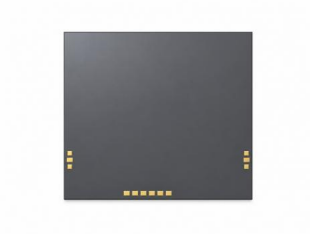
Einfügedämpfung: Typisch: 1.6; Einheit: dB

Dämpfungsbereich: Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

RMS-Dämpfungsfehler: Typisch: 0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz 4-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 92.5 ps (typisch) (T1; t_nom = 92.59 ps); Zeitverzögerung: 737 ps (typisch) (T4; t_nom = 740.74 ps); Einfügedämpfung: 12 dB (typisch) / 13 dB (Maximum). Chipabmessungen: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 12; Maximum: 13; Einheit: dB

Zeitverzögerung (T1): Typisch: 92.5; Wert: T1; t_nom = 92.59 ps; Einheit: ps

Zeitverzögerung (T2): Typisch: 184; Wert: T2; t_nom = 185.185 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz 4-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 52.7 ps (typisch) (T1; t_nom = 52 ps); Zeitverzögerung: 416 ps (typisch) (T4; t_nom = 416 ps); Einfügedämpfung: 12 dB (typisch) / 13 dB (Maximum). Chipabmessungen: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8500; Maximum: 10500; Wert: 8500–10500; Einheit: MHz

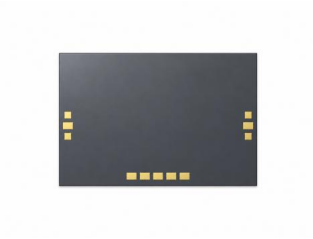
Einfügedämpfung: Typisch: 12; Maximum: 13; Einheit: dB

Zeitverzögerung (T1): Typisch: 52.7; Wert: T1; t_nom = 52 ps; Einheit: ps

Zeitverzögerung (T2): Typisch: 102; Wert: T2; t_nom = 104 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz 3-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 25 ps (typisch) (T1; t_nom = 25 ps); Zeitverzögerung: 102 ps (typisch) (T3; t_nom = 100 ps); Einfügedämpfung: 6 dB (typisch) / 7 dB (Maximum). Chipabmessungen: 3 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

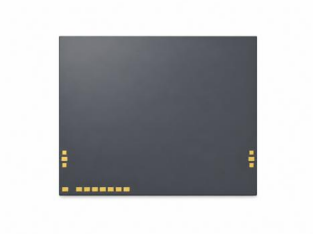
Einfügedämpfung: Typisch: 6; Maximum: 7; Einheit: dB

Zeitverzögerung (T1): Typisch: 25; Wert: T1; t_nom = 25 ps; Einheit: ps

Zeitverzögerung (T2): Typisch: 49.5; Wert: T2; t_nom = 50 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 25 ps (typisch) (T1; t_nom = 25 ps); Zeitverzögerung: 800 ps (typisch) (T6; t_nom = 800 ps); Einfügedämpfung: 11 dB (Maximum). Chipabmessungen: 5 × 4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 200; Maximum: 2000; Wert: 200–2000; Einheit: MHz

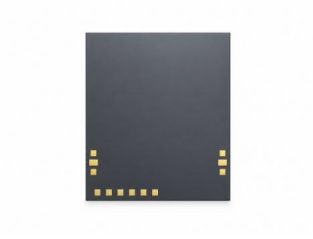
Einfügedämpfung: Maximum: 11; Einheit: dB

Zeitverzögerung (T1): Typisch: 25; Einheit: ps; Hinweise: T1; t_nom = 25 ps

Zeitverzögerung (T2): Typisch: 50; Einheit: ps; Hinweise: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz 3-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 52 ps (typisch) (T1; t_nom = 52 ps); Zeitverzögerung: 208 ps (typisch) (T3; t_nom = 208 ps); Einfügedämpfung: 9 dB (typisch). Chipabmessungen: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

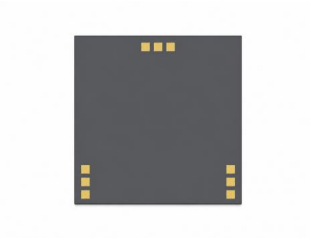
Einfügedämpfung: Typisch: 9; Einheit: dB

Zeitverzögerung (T1): Typisch: 52; Wert: T1; t_nom = 52 ps; Einheit: ps

Zeitverzögerung (T2): Typisch: 104; Wert: T2; t_nom = 104 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 3700; Maximum: 5000; Wert: 3700–5000; Einheit: MHz

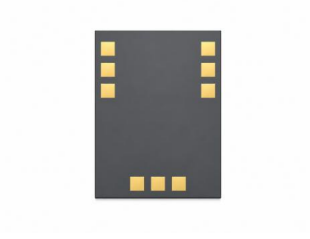
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 14 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 500; Maximum: 2700; Wert: 500–2700; Einheit: MHz

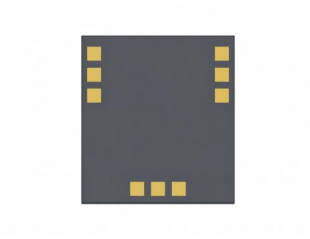
Isolation: Typisch: 14; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

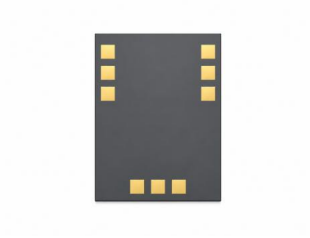
Isolation: Typisch: 18; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.4 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.4 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 1000; Maximum: 4000; Wert: 1000–4000; Einheit: MHz

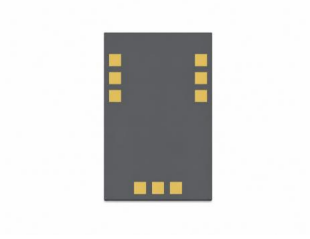
Isolation: Typisch: 18; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.4

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

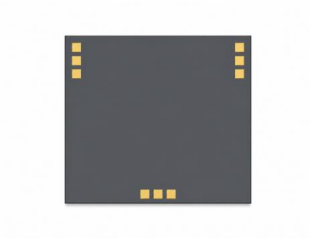
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

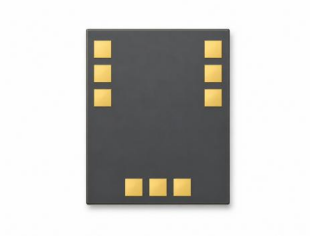
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

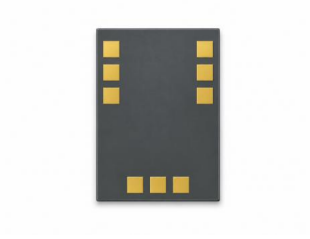
Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.1

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 7000; Wert: 5000–7000; Einheit: MHz

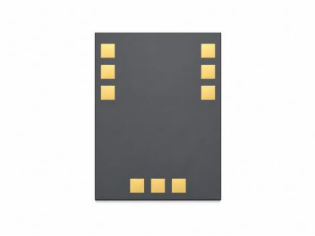
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.1

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

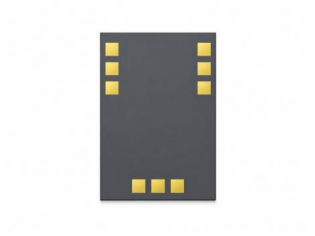
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

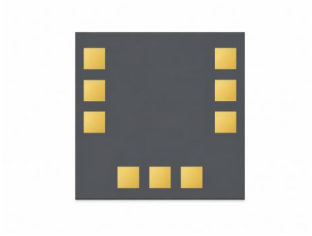
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

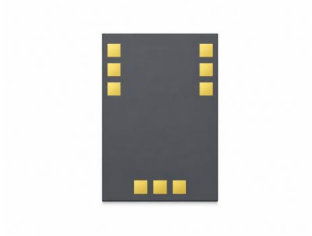
Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 10000; Maximum: 20000; Wert: 10000–20000; Einheit: MHz

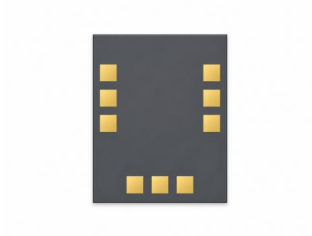
Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

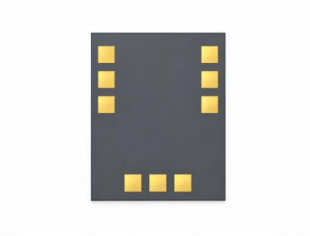
Isolation: Typisch: 25; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.2

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 30000; Maximum: 40000; Wert: 30000–40000; Einheit: MHz

Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

Ausgangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 15 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.35 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.8 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

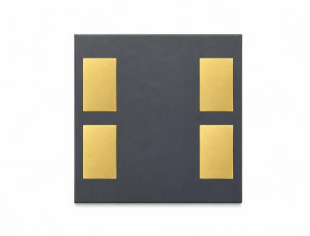
Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

Widerstand: Typisch: 15; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 20 / 20 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.165 / 0.165 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.33 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 2

Anzahl der Anschlüsse: Wert: 4

Widerstand: Typisch: 20 / 20; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 50 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.2 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.6 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

Widerstand: Typisch: 50; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 1000 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.04 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.08 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

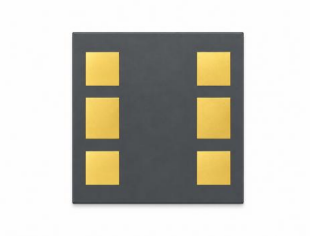
Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

Widerstand: Typisch: 1000; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCCAP-C10PF

10 pF GaAs-Kondensatorchip

Kapazität: 10 pF (typisch); Spannungsfestigkeit: 50 V (typisch). Chipabmessungen: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Kapazität: Typisch: 10; Einheit: pF; TA = +25 °C

Spannungsfestigkeit: Typisch: 50; Einheit: V; TA = +25 °C

Durchbruchspannung: Wert: 80 (Vb); Einheit: V

Lagertemperatur: Minimum: -65; Maximum: 150; Einheit: °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 2 dB; Einfügedämpfung @ 8000 MHz: 2.6 dB; Einfügedämpfung @ 12000 MHz: 0.7 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

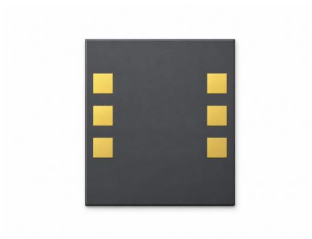
Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Entzerrungsbetrag: Wert: 2; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 8000 MHz: Wert: 2.6; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 12000 MHz: Wert: 0.7; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 5.5 dB; Einfügedämpfung @ 2000 MHz: 0.6 dB; Einfügedämpfung @ 6000 MHz: 6.1 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

Entzerrungsbetrag: Wert: 5.5; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 2000 MHz: Wert: 0.6; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 6000 MHz: Wert: 6.1; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.2 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.2

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 4 dB

Dämpfung: 4 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 4; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 16 dB

Dämpfung: 16 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 16; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.6 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.4 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.4

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 5 dB

Dämpfung: 5 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 5; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 6 dB

Dämpfung: 6 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 6; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 10 dB

Dämpfung: 10 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

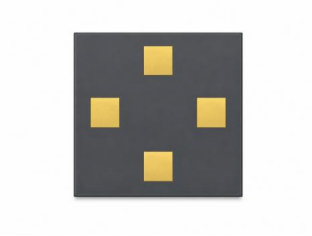
Dämpfung: Wert: 10; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz GaAs-RF-Kreuzungsbrückenchip

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Isolation: 30 dB (typisch); Rückflussdämpfung: 20 dB (typisch). Chipabmessungen: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 40000; Wert: DC–40000; Einheit: MHz

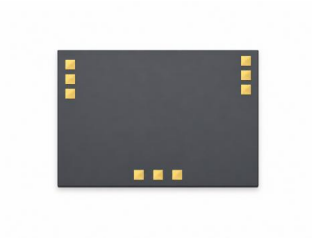
Einfügedämpfung: Typisch: 0.4; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Rückflussdämpfung: Typisch: 20; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz Passiver doppelt symmetrischer GaAs-MMIC-Mischer als Bare Die

Konversionsverlust: 9 dB (typisch); LO-Leistung: 15 dBm; Betriebsfrequenz (IF): 0 MHz (Minimum) / 900 MHz (Maximum) / DC–900 MHz. Chipabmessungen: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 500; Maximum: 2000; Wert: 500–2000 (RF / LO); Einheit: MHz

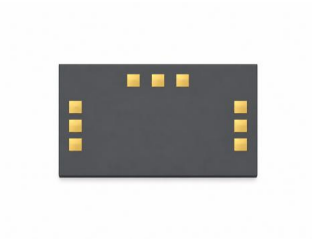
Betriebsfrequenz (IF): Minimum: 0; Maximum: 900; Wert: DC–900; Einheit: MHz

Konversionsverlust: Typisch: 9; Einheit: dB

Isolation (LO / RF): Typisch: 45; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz Passiver doppelt symmetrischer GaAs-MMIC-Mischer als Bare Die

Konversionsverlust: 8.5 dB (typisch); LO-Leistung: 14 dBm; Betriebsfrequenz (IF): 1400 MHz (Minimum) / 3000 MHz (Maximum) / 1400–3000 MHz. Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 7000; Maximum: 10000; Wert: 7000–10000 (RF); Einheit: MHz

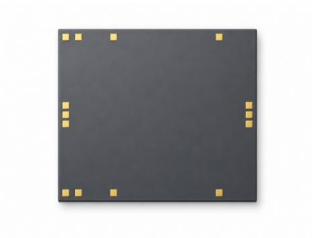
Betriebsfrequenz (LO): Minimum: 5000; Maximum: 9000; Wert: 5000–9000; Einheit: MHz

Betriebsfrequenz (IF): Minimum: 1400; Maximum: 3000; Wert: 1400–3000; Einheit: MHz

Konversionsverlust: Typisch: 8.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS42T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 20 % (typisch); Chipabmessungen: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41.2; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 16.2; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS29T

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 29 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 14 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 15 % (typisch); Chipabmessungen: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 13; Typisch: 14; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 29; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

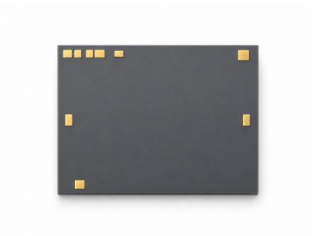
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 20; Typisch: 20.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 2.8 × 2.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

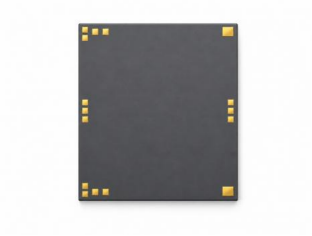
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 39.5; Typisch: 40.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21.5; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 42 % (typisch); Chipabmessungen: 3.17 × 3.58 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

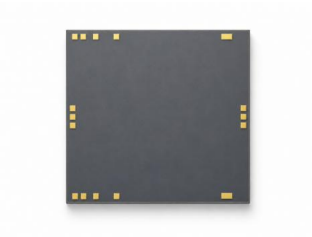
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44.8; Typisch: 45.8; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 17.8; Typisch: 18.8; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4000-10000-PS45T

4000–10000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–10000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 10000; Einheit: MHz

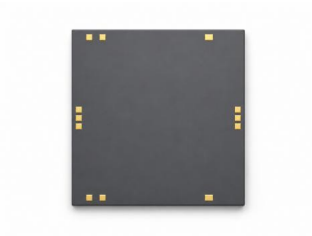
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 43.8; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 15.8; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

2500–6200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 6200; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 17.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

8500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 47 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

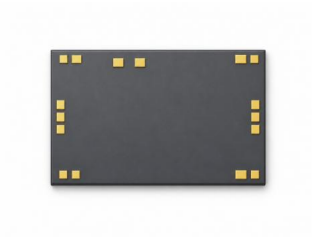
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.8; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 21.8; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 43 % (typisch); Chipabmessungen: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41.2; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21.2; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-18000-PS40T

2000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

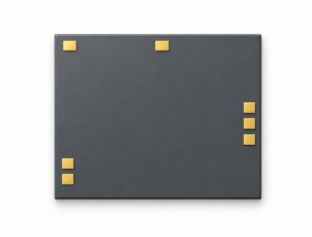
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 40; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 12; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 33.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 12 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 20 % (typisch); Chipabmessungen: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

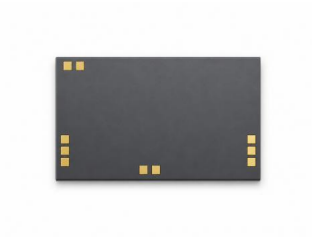
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 33; Typisch: 33.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 11; Typisch: 12; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-18000-PS35T

2000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 7 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

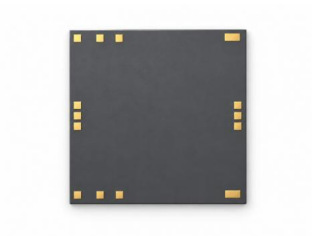
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 7; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

9200–10400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

9200–10400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.2 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.2 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 9200; Maximum: 10400; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.2; Maximum: 46.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.2; Maximum: 24.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-7500-10500-PS49T

7500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

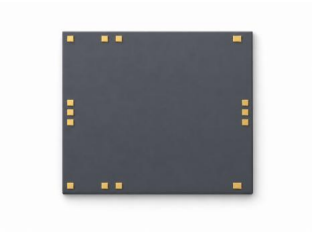
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 48.6; Typisch: 49; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24.6; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-7000-13000-PS45T

7000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS45T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 23 % (typisch); Chipabmessungen: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44.5; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19.5; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

5000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 49.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 26.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

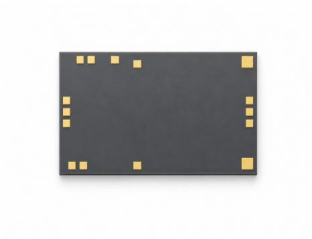
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 49; Typisch: 49.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 26; Typisch: 26.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS40T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 23 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

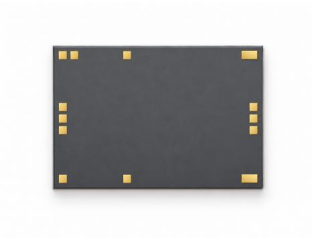
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 39; Typisch: 40; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 18; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-10000-18000-PS41T

10000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

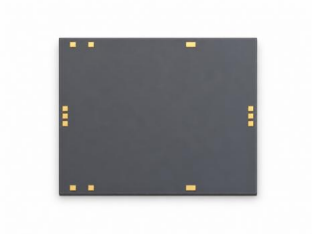
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 40.9; Typisch: 41; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 18.9; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

950–1250 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

950–1250 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 60 % (typisch); Chipabmessungen: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 950; Maximum: 1250; Einheit: MHz

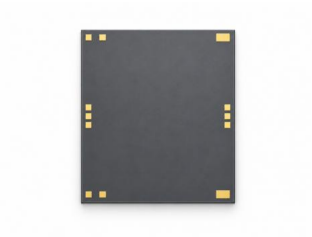
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

5000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 53 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

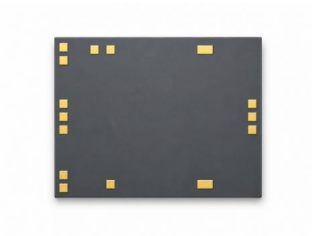
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 39 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 43 % (typisch); Chipabmessungen: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 38; Typisch: 39; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.7; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8500-10500-PS52T

8500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 52 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 52; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

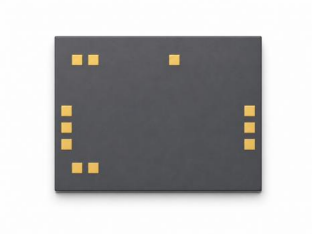
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 17.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4000-8000-PS37T

4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20 dB (typisch); PAE 35% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

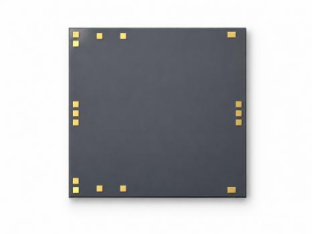
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 36.5; Typisch: 37; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19.5; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS47T

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

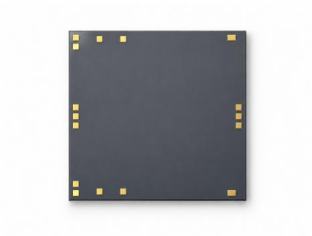
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46.5; Typisch: 47; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

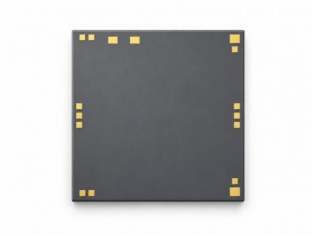
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46.5; Typisch: 47; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

3600–5000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 23.5 dB (typisch); PAE 43% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 3600; Maximum: 5000; Einheit: MHz

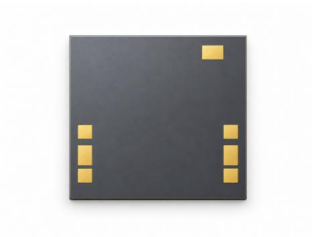
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 23; Typisch: 23.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-5000-13000-PS25T

5000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 25 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 10 dB (typisch); Chipabmessungen: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

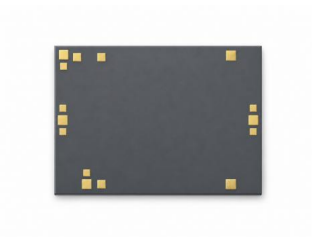
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 25; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 10; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-5000-13000-PS42T

5000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 35 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4200-7000-PS42T

4200–7000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22 dB (typisch); PAE 45% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4200; Maximum: 7000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41.8; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 21.8; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20.5 dB (typisch); PAE 35% (typisch); CW; Vd = +24 V.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

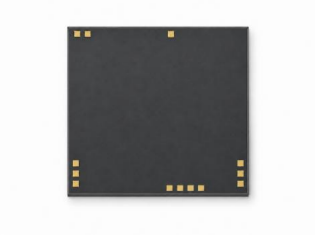
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 20; Typisch: 20.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

200–2200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

GaN-on-SiC-Verstärkerchip für 200–2200 MHz mit typisch 41.5 dBm Sättigungsleistung, typisch 25.5 dB Leistungsverstärkung und Abmessungen von 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 200; Maximum: 2200; Einheit: MHz

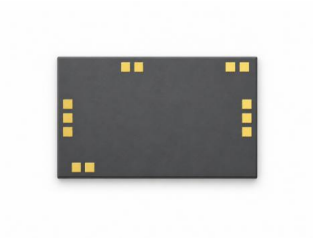
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41.0; Typisch: 41.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 25.0; Typisch: 25.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.0; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-3400-5600-PS40T

3400–5600 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17 dB (typisch); PAE 46% (typisch); CW.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 3400; Maximum: 5600; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 39; Typisch: 40; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 16; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-5800-6800-PS47T

5800–6800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5800–6800 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 46 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5800; Maximum: 6800; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 47; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

2700–3500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 25.5 dB (typisch); PAE 58% (typisch); CW.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 25; Typisch: 25.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6700-7400-PS41T

6700–7400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6700–7400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 55 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6700; Maximum: 7400; Einheit: MHz

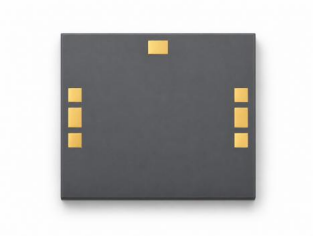
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS27T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 27 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 9 dB (typisch); Chipabmessungen: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

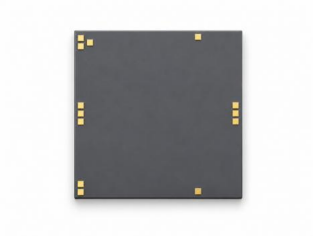
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 26; Typisch: 27; Maximum: 29; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 8; Typisch: 9; Maximum: 11; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-8000-PS42T

2000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 15 dB (typisch); PAE 30% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

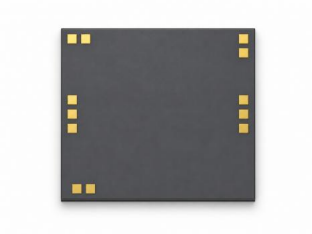
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41; Typisch: 42; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 14; Typisch: 15; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

2500–3700 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22.5 dB (typisch); PAE 50% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 3700; Einheit: MHz

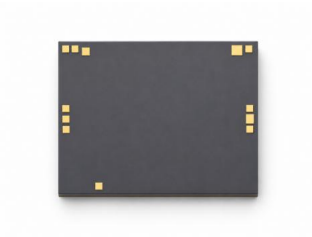
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 41; Typisch: 41.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

2600–3300 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 25.5 dB (typisch); PAE 60% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2600; Maximum: 3300; Einheit: MHz

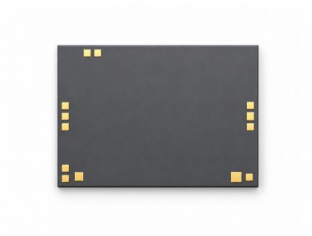
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 25; Typisch: 25.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

2400–3800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 27.5 dB (typisch); PAE 56% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2400; Maximum: 3800; Einheit: MHz

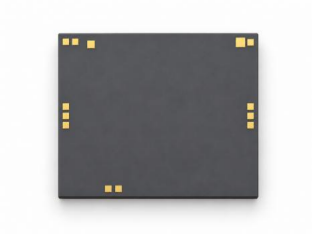
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 27; Typisch: 27.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2500-4000-PS47T

2500–4000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26 dB (typisch); PAE 52% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 4000; Einheit: MHz

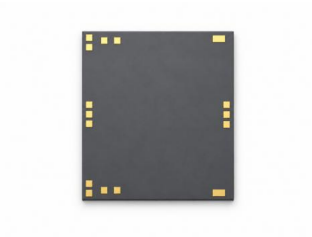
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46.2; Typisch: 47; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 25.2; Typisch: 26; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-9400-PS45T

8000–9400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–9400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 31 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 9400; Einheit: MHz

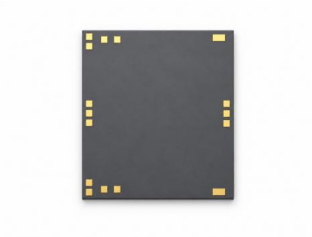
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 31; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

8000–9400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–9400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 31 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 9400; Einheit: MHz

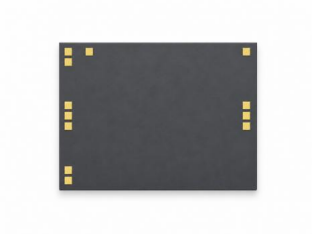
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 31; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

1200–1600 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1200–1600 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 60 % (typisch); Chipabmessungen: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 1600; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 28 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

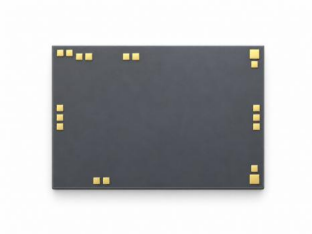
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Maximum: 47.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-4400-6500-PS44T

4400–6500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4400–6500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 27 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 47 % (typisch); Chipabmessungen: 3.51 × 2.44 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4400; Maximum: 6500; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 43.5; Typisch: 44; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 26.5; Typisch: 27; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

2700–3500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 61% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Einheit: MHz

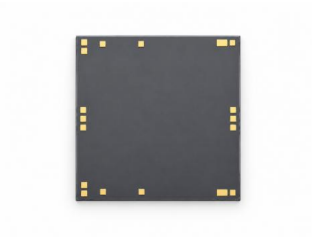
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 26; Typisch: 26.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-10800-13000-PS45T

10800–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10800–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 10800; Maximum: 13000; Einheit: MHz

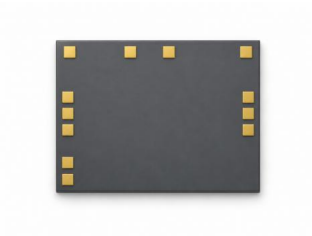
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-9000-11000-PS37T

9000–11000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

9000–11000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 37 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 11000; Einheit: MHz

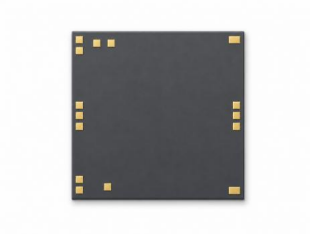
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 37; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-8400-PS45T

8000–8400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–8400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 23 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 55 % (typisch); Chipabmessungen: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 8400; Einheit: MHz

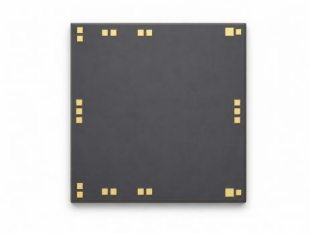
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 23; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

3700–5000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 27 dB (typisch); PAE 48% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 3700; Maximum: 5000; Einheit: MHz

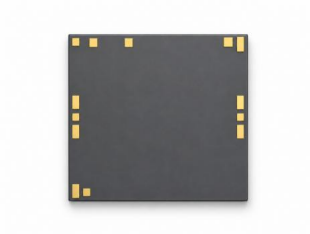
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.2; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 26.8; Typisch: 27; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 26.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 2.9 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

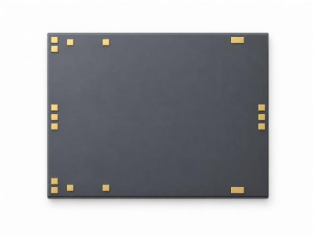
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 42.5; Typisch: 43; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 25.5; Typisch: 26.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-18000-PS44T

6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 44; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-18000-PS44T

8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

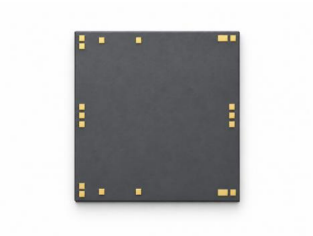
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 44; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 19; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-10000-13000-PS45T

10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

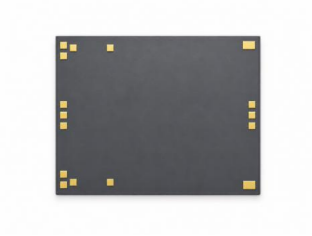
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

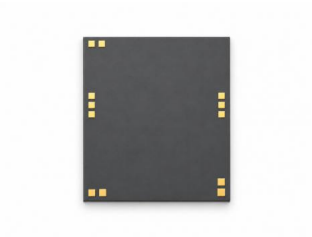
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 19.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-2800-PS41T

2000–2800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–2800 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 56 % (typisch); Chipabmessungen: 2.4 × 2.7 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 2800; Einheit: MHz

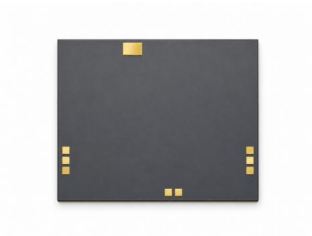
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 40.7; Typisch: 41; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 23.7; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

300–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

300–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 12.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 40; Typisch: 40.8; Maximum: 41.6; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 12; Typisch: 12.8; Maximum: 13.6; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2000-18500-PS43T

2000–18500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18500; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 43; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 13; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

1950–4050 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1950–4050 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3.56 × 3.78 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 1950; Maximum: 4050; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-300-6000-PS30T

300–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

300–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 30 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 15 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 15 % (typisch); Chipabmessungen: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 28; Typisch: 30; Maximum: 32.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 13; Typisch: 15; Maximum: 17.5; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Typisch: ±2.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-2700-3900-PS48T

2700–3900 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 56% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47.6; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 23.6; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.6; Einheit: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 30.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 30 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 22 % (typisch); Chipabmessungen: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 30; Typisch: 30.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 30; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-10000-13000-PS48T

10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 37 % (typisch); Chipabmessungen: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

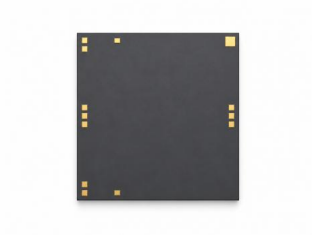
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-1200-2400-PS45T

1200–2400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1200–2400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 53 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 2400; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Minimum: 44.5; Typisch: 45; Maximum: 45.5; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-6000-12000-PS48T

6000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-PA-7000-13000-PS48T

7000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

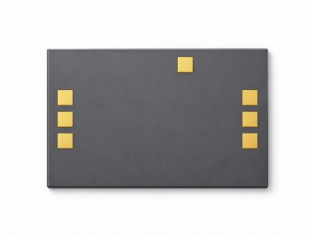
Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Leistungsverstärkung: Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB (typisch)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); P1dB 6 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

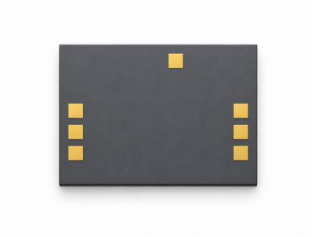
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 6; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.9 dB (typisch)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

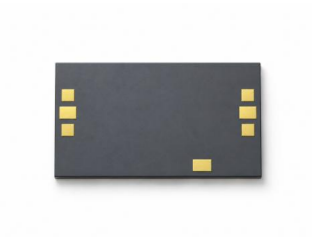
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1 dB (typisch)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

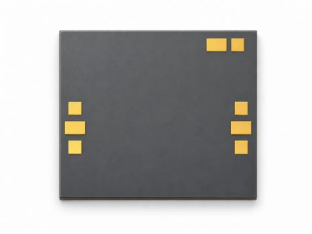
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 6; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Minimum: 28; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.8 dB (typisch)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

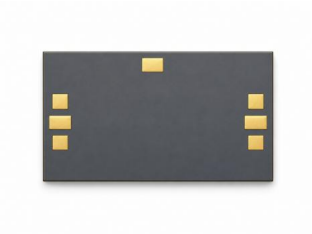
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 10; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Minimum: 29; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.2 dB (typisch)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch); P1dB 8 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

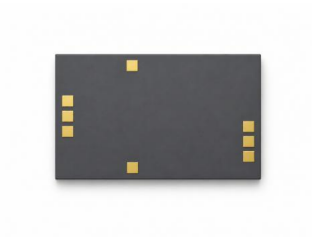
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 8; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 22; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 2.5 dB (typisch)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); P1dB ≥ 11 dBm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 24000; Maximum: 40000; Wert: 24000–40000; Einheit: MHz

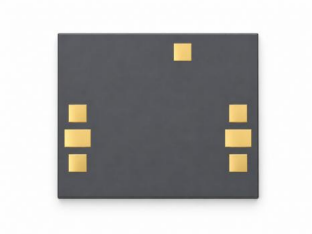
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Minimum: 11; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.7 dB (typisch)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB 8 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

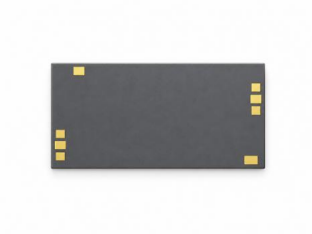
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Minimum: 7; Typisch: 8; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Minimum: 25; Typisch: 26; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 2 dB (typisch)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 17 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 20000; Wert: 2000–20000; Einheit: MHz

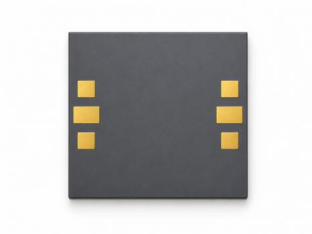
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.1 dB (typisch)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 17.5 dB (typisch); P1dB 19.5 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 2000; Wert: 100–2000; Einheit: MHz

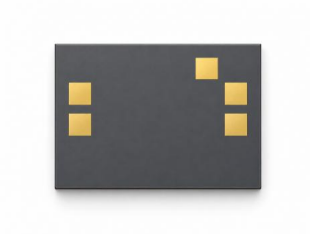
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 19.5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 17.5; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); P1dB 20.5 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

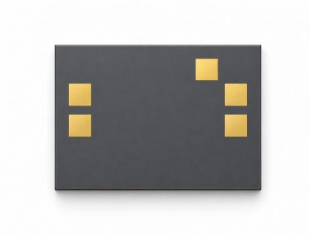
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 20.5; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 22; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.4 dB (typisch)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); P1dB 21 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 200; Maximum: 600; Wert: 200–600; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 21; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 22.5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 30 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 15; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 30; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Kleinsignalverstärkung 31 dB (typisch); P1dB 15 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 9000; Wert: 7000–9000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 15; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 31; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.2 dB (typisch)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB -2 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 20000; Wert: 6000–20000; Einheit: MHz

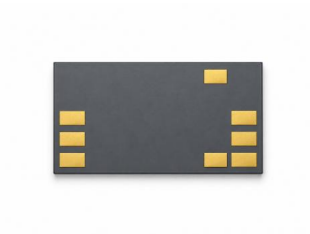
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Minimum: -4; Typisch: -2; Maximum: 0; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB (typisch)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 34.5 dB (typisch); P1dB 7 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 12000; Wert: 4000–12000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Minimum: 6.5; Typisch: 7; Maximum: 8.5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 34.5; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch); P1dB 11 dBm (typisch)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 30 dB (typisch); P1dB 11 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

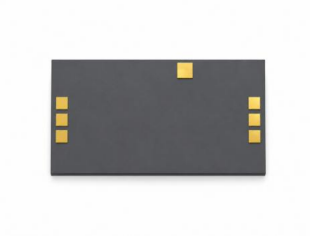
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 11; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 12; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 30; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.8 dB (typisch)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB 5 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 32000; Maximum: 52000; Wert: 32000–52000; Einheit: MHz

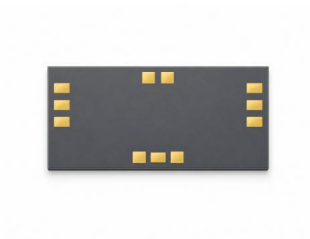
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1 dB (typisch)

12000–18000 MHz; Einfügedämpfung 1 dB (typisch); Isolation 38 dB (typisch); P0.2dB 44 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 1; Maximum: 1.2; Einheit: dB

Isolation: Minimum: 36; Typisch: 38; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 44; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1 dB (typisch)

32000–38000 MHz; Einfügedämpfung 1 dB (typisch); Isolation 20 dB (typisch); P0.2dB 42 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 32000; Maximum: 38000; Wert: 32000–38000; Einheit: MHz

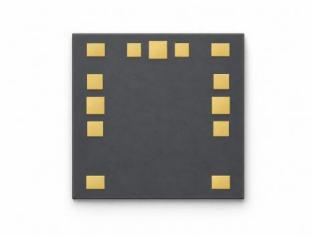
Einfügedämpfung: Typisch: 1; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 20; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 42; Einheit: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.9 dB (typisch)

2000–18000 MHz; Einfügedämpfung 0.9 dB (typisch); Isolation 23 dB (typisch); P0.2dB 37 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

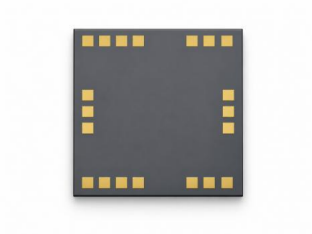
Einfügedämpfung: Typisch: 0.9; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 23; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 37; Einheit: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs SP3T-MMIC-Schalter als Bare Die — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Isolation (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung (100–2000 MHz): Maximum: 1.4; Wert: f = 100–2000 MHz; Einheit: dB

Einfügedämpfung (2000–20000 MHz): Maximum: 2.8; Wert: f = 2000–20000 MHz; Einheit: dB

Isolation (100–2000 MHz): Maximum: 65; Wert: f = 100–2000 MHz; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1.6 dB (typisch)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung 1.6 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz; TA = +25 °C

Einfügedämpfung: Typisch: 1.6; Einheit: dB; TA = +25 °C

Isolation: Typisch: 45; Einheit: dB; TA = +25 °C

Ruhestrom der negativen Versorgung: Typisch: 0.0012; Einheit: A

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.9 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Einfügedämpfung 0.9 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch); P0.2dB 46 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

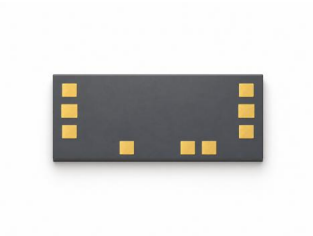
Einfügedämpfung: Typisch: 0.9; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 45; Maximum: 50; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 46; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs SPST-MMIC-Schalter als Bare Die — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Einfügedämpfung ≤ 1.2 dB; Isolation 60 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Maximum: 1.2; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 60; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR (leitend): Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.7 dB (typisch)

2700–3500 MHz; Einfügedämpfung 0.7 dB (typisch); Isolation 41 dB (typisch); P0.2dB 51 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

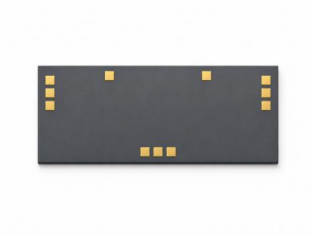
Einfügedämpfung: Typisch: 0.7; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 41; Maximum: 43; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 51; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.7 dB (typisch)

100–6000 MHz; Einfügedämpfung 0.7 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch); P0.2dB 47 dBm (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 6000; Wert: 100–6000; Einheit: MHz

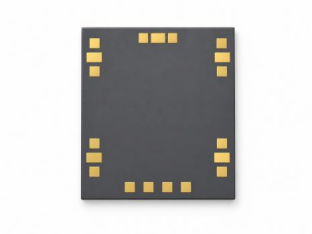
Einfügedämpfung: Typisch: 0.7; Maximum: 0.8; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 45; Einheit: dB

Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: Typisch: 47; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs SP4T-MMIC-Schalter als Bare Die — IL −2 dB (typisch)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung -2 dB (typisch); Isolation -50 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

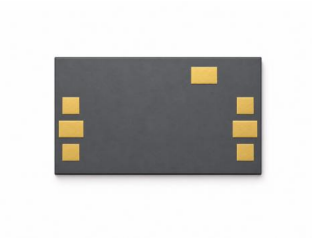
Einfügedämpfung: Typisch: -2; Einheit: dB

Isolation: Typisch: -50; Einheit: dB

Eingangs-VSWR: Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 16 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 24 dB (typisch); NF 1.7 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

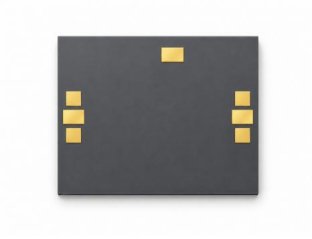
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 16; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 24; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 19 dBm (typisch)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 14 dB (typisch); NF 2.5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 700; Maximum: 5000; Wert: 700–5000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 19; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 14; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); NF 3.5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

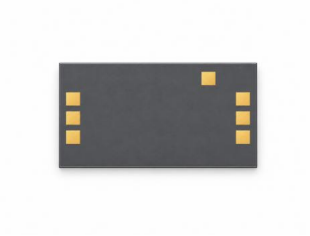
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 23.5; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 25; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23 dBm (typisch)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 19 dB (typisch); NF 5.5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

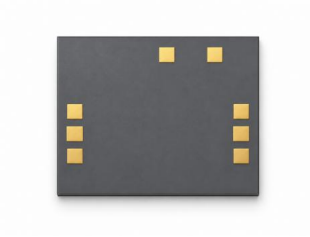
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 23; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 24; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 19; Maximum: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 20 dBm (typisch)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 6.5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 20000; Wert: 5000–20000; Einheit: MHz

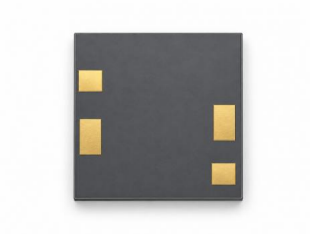
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 20; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 21; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 22.8 dBm (typisch)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 1.8 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

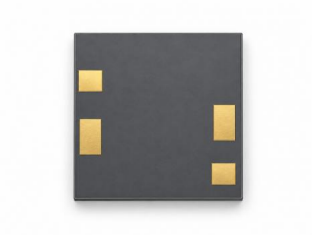
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 22.8; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 21 dBm (typisch)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 20 dB (typisch); NF 1 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

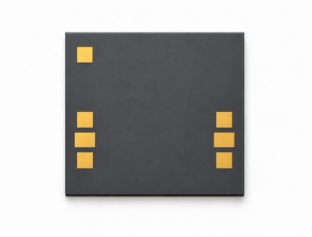
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 21; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 15 dBm (typisch)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 17 dB (typisch); NF 1.4 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

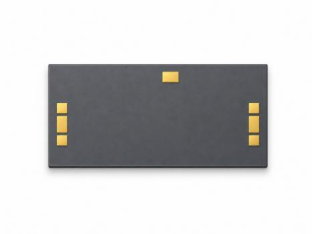
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 15; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 17; Einheit: dB

Welligkeit der Kleinsignalverstärkung: Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23.5 dBm (typisch)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 7000; Wert: 2000–7000; Einheit: MHz

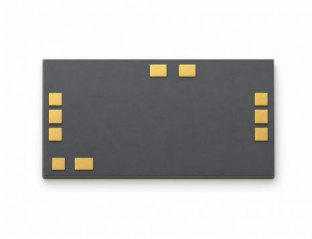
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 23.5; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 24.5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — PSAT 28 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

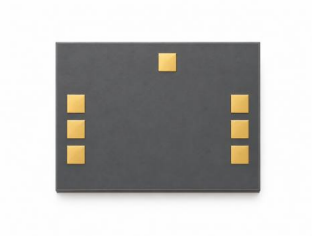
Sättigungsausgangsleistung: Minimum: 27.8; Typisch: 28; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Typisch: 19; Einheit: dB

Leistungsaddierte Effizienz: Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 17 dBm (typisch)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 13 dB (typisch); NF 3.5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 9000; Wert: 4000–9000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 17; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 18; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 13; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 16 dBm (typisch)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 3 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

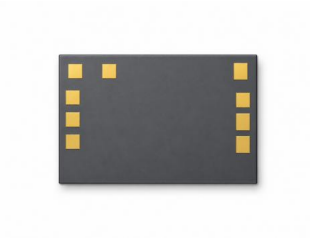
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 16; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 17; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23 dBm (typisch)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); NF 5 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 12000; Wert: 6000–12000; Einheit: MHz

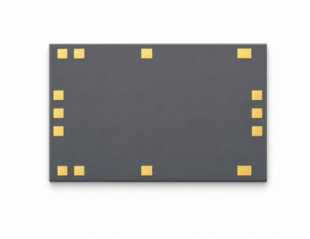
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: Symbol: P1dB; Typisch: 23; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung: Symbol: Psat; Wert: 23.8; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung: Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — PSAT 25 dBm (typisch)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 24000; Maximum: 31000; Wert: 24000–31000; Einheit: MHz

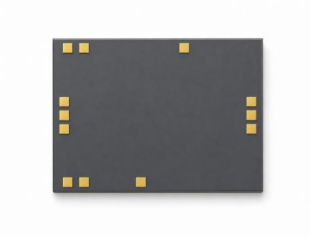
Kleinsignalverstärkung: Typisch: 22; Einheit: dB

Sättigungsausgangsleistung: Typisch: 25; Einheit: dBm

Leistungsverstärkung: Typisch: 20; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz Bidirektionaler GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — Rx / Tx P1dB 24 dBm (typisch)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Wert: 8000–18000; Einheit: MHz

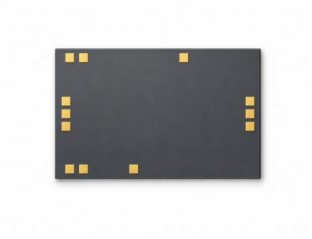
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx): Typisch: 24; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung (Rx): Typisch: 24.5; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung (Rx): Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz Bidirektionaler GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — Rx / Tx P1dB 21 dBm (typisch)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 19 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx): Typisch: 21; Einheit: dBm

Sättigungsausgangsleistung (Rx): Typisch: 22; Einheit: dBm

Kleinsignalverstärkung (Rx): Typisch: 19; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die — Rx 13 dB / Tx 27 dB (typisch)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (typisch); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

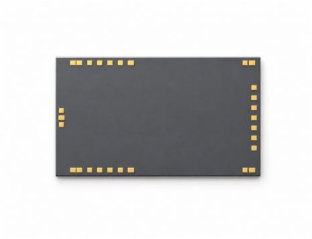
Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

Dämpfungsbereich: Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

Kleinsignalverstärkung (Rx): Typisch: 13; Einheit: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz Zweikanal-GaAs-MMIC zur Phasen- und Dämpfungssteuerung als Bare Die — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; Einfügedämpfung -13 dB (typisch); RMS-Dämpfungsfehler über 64 Zustände 0.2 dB (typisch); RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 2 ° (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 3700; Maximum: 5000; Wert: 3700–5000; Einheit: MHz

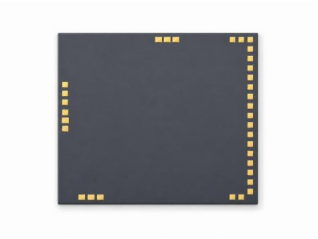
Einfügedämpfung: Typisch: -13; Einheit: dB

Dämpfungsbereich: Maximum: 31.5; Einheit: dB

RMS-Dämpfungsfehler über 64 Zustände: Typisch: 0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die — Rx 10 dB / Tx 26 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (typisch); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Phasenstellbereich: Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

Dämpfungsbereich: Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

Kleinsignalverstärkung (Rx): Typisch: 10; Einheit: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs Bandpassfilter als Bare Die — IL 2.7 dB (typisch)

17000–19000 MHz; Einfügedämpfung 2.7 dB (typisch).

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 17000; Maximum: 19000; Wert: 17000–19000; Einheit: MHz

Mittenfrequenz: Typisch: 18000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 2.7; Einheit: dB

Welligkeit im Durchlassband: Typisch: 0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.